

Отзыв научного руководителя

о работе Вороненкова Владислава Валерьевича, представившего диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 01.04.10 "Физика полупроводников"
"Оптимизация технологических условий эпитаксиального роста толстых слоев нитрида галлия"

В.В. Вороненков занимается научной работой по тематике диссертации с 2009 года, когда он поступил в аспирантуру кафедры физики полупроводников радиофизического факультета С.-Петербургского государственного политехнического университета. Он проявил себя грамотным, заинтересованным аспирантом, имеющим способность к самостоятельной научной работе. За годы обучения в аспирантуре показал умение проводить экспериментальные исследования и теоретические расчеты, самостоятельно готовить публикации результатов и предлагать новые исследования.

За время подготовки диссертационной работы им лично был получен ряд новых и интересных научных результатов в области физики дефектов и технологии выращивания нитрида галлия методом хлорид—гидридной газофазной эпитаксии, которые получили практическое применение и позволили уменьшить количество дефектов в выращиваемых слоях. Результаты работы В.В. Вороненкова опубликованы в ведущих научных журналах и представлены на российских и международных конференциях.

Считаю, что В.В. Вороненков является талантливым и высококвалифицированным человеком, способным самостоятельно и на высоком уровне вести научные исследования, его диссертационная работа удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, а сам он заслуживает присуждения искомой степени.

Научный руководитель,
доктор физико-математических наук,
профессор, Юрий Георгиевич Шретер.
*Главный научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук
Адрес: 194223, Санкт-Петербург,
ул. Жака Дюкло, д. 8, к. 1, кв.13
телефон: 5527888
электронная почта: Y.Shreter@mail.ioffe.ru*